知能制御システム学

イメージセンサの基礎

東北大学 大学院情報科学研究科 鏡 慎吾 swk(at)ic.is.tohoku.ac.jp

2005.04.19

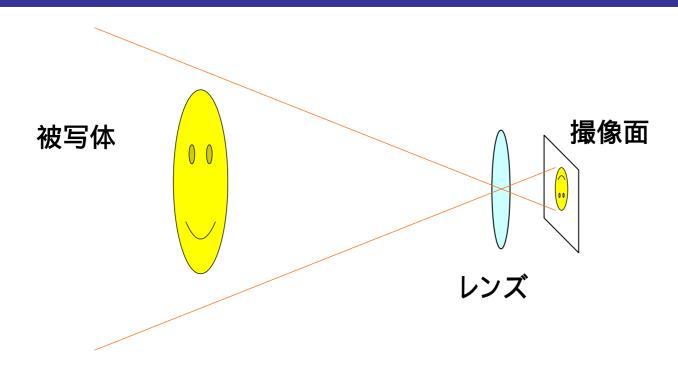
今日の目的

コンピュータビジョン、ビジュアルサーボなどの技術 における「情報の入り口」であるイメージセンサ技術 の基礎を学ぶ

CCD, CMOSイメージセンサの仕組み, 違い, 特性を 理解する

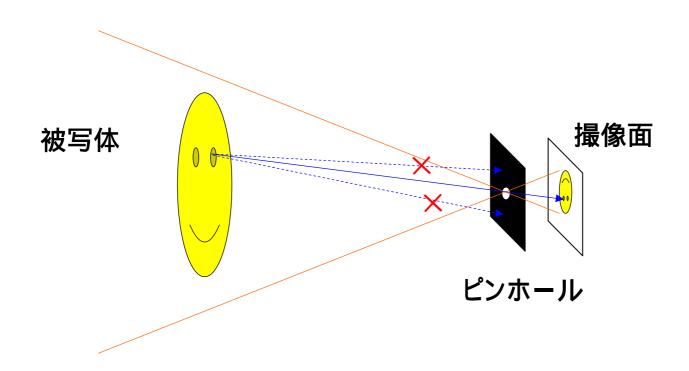
[米本2003] [Wong1999]

イメージセンサ,カメラとは



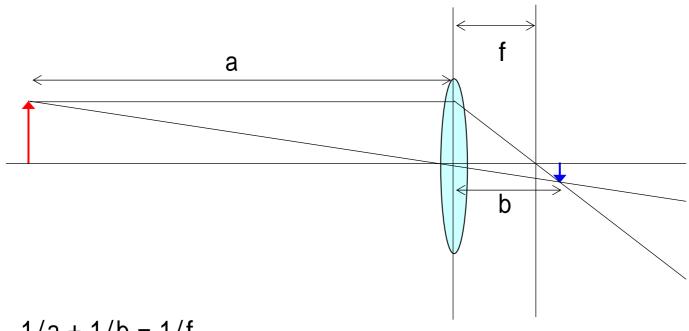
- ・被写体から出た光が,レンズを通して撮像面に結像する (3D 2D)
- 撮像面における明るさの度合い(後でちゃんと定義)を,何らかの信号として読み出す(2D 2D).普通は電気信号.
- レンズ系などを含めた 3D 2D の変換系全体をカメラと呼ぶことが多い
- ・撮像面の 2D光分布 信号出力 の部分をイメージセンサと呼ぶことが多い

ちょっとだけ光学系の話



- •基本はピンホールレンズである.
- •撮像面のある一点に当たる光は,その点とピンホールを結ぶ直線上の どこかから発せられたものである.
- •被写体までの距離は理論上無制限
- •ピンホールを通らない光は無駄 光量を稼げない

(理想)レンズ



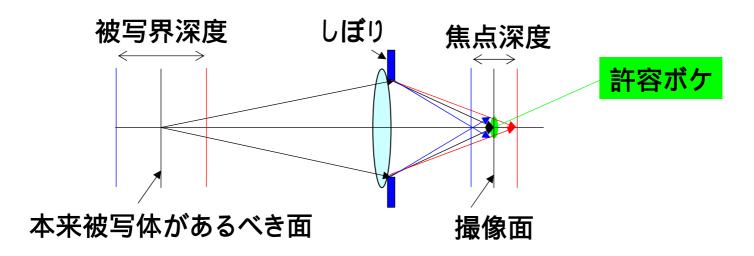
1/a + 1/b = 1/f を満たすような a, b を考える.

距離 a の位置にある被写体だけが距離 b の面に結像する

ピンホールとは違って被写体を置ける位置は一定距離に限られるが、より多くの光を集めることができる.

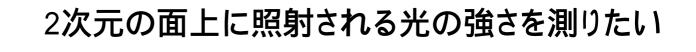
理想レンズの被写界深度

ではある一定の距離にあるぺらぺらのものしか写せないのか? 被写界深度の範囲内ならば大丈夫



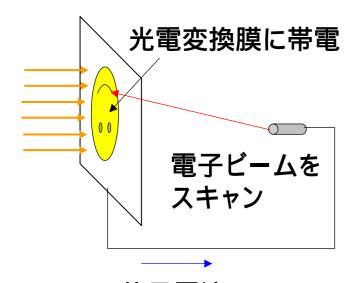
- 許容ボケの範囲内なら光線がずれてもわからない(撮像素子の空間解像 度は,固体撮像素子だろうと銀塩だろうと有限である).
- 許容の大きさと,レンズの有効口径との幾何学的関係から焦点深度が決まり,1/f = 1/a+1/bから被写界深度が決まる
- レンズを絞れば絞るほど、ピントが合いやすくなる.(その分暗くなる)

撮像



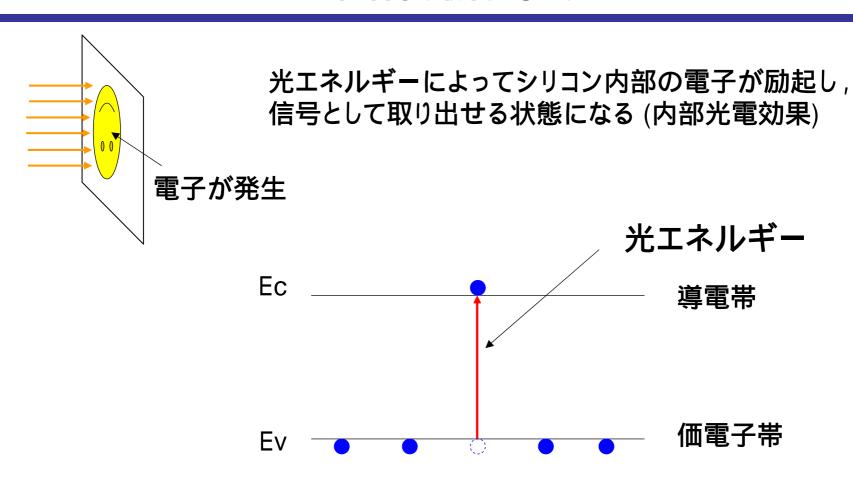
化学物質が分解

人間の目: 光エネルギーによって視細胞の中の物質(ロドプシン)が分解し, それがきっかけとなって神経細胞が興奮する



- 銀塩カメラ: 光エネルギーでハロゲン化銀を 分解
 - $2AgBr + photon \qquad 2Ag + Br_2$
- 撮像管: 光エネルギーで電荷が発生し, それを電子ビームの走査で順に信号電流として読み出す

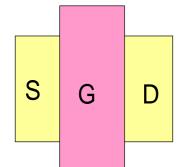
固体撮像素子

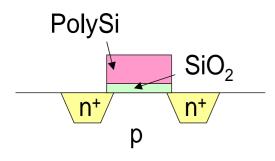


半導体の予備知識

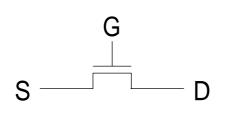
シリコン上に,不純物やら酸化膜やらを整形して回路を集積する

上面から見たところ

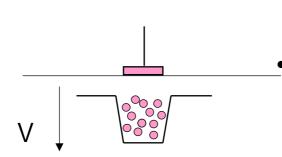


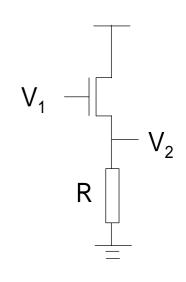


断面から見たところ



Gに電圧をかけると S と D の間に電流を流 せるようになる (= MOS スイッチ)

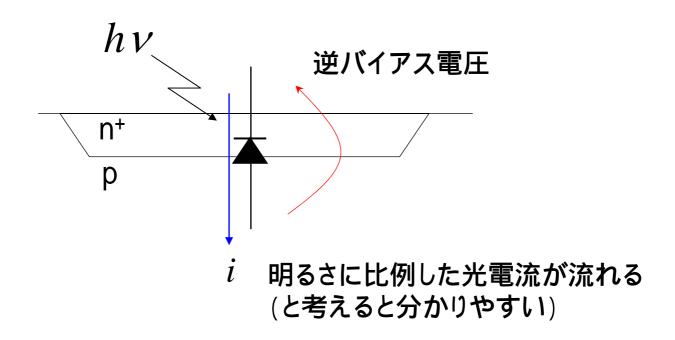




• 局所的に電位の高い場所を作ると,そこに電子 をためたりできる

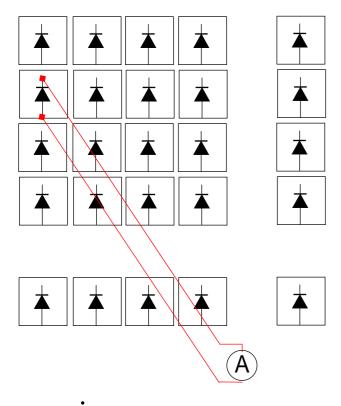
光電変換 (フォトダイオード)

フォトダイオードと呼ばれる構造を用いることが多い



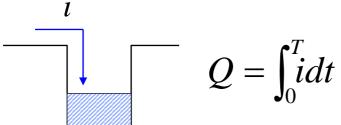
- •光通信用のフォトダイオードなどでは,この光電流を増幅して信号 検出に利用する.
- •イメージセンサでは、これを画素でいったん蓄積することが多い

光電流の蓄積



画素数の本数だけ(1メガピクセルなら 100万本)信号線を引き出して来れない限り,時分割多重で読み出す必要がある

ある画素の信号を読んでいる間,他の信号が捨てられるようではもったいない(光電流は微弱である)



時間積分することで,雑音成分を相対的に低減する(S/N比を上げる)

ポテンシャルの井戸を作りそこに電荷を 閉じ込める

固体撮像素子: CCD と CMOS

現在の主流は大きく二つに分かれる

CCDイメージセンサ

CMOSイメージセンサ

特殊な製造プロセス

高感度·低雑音

消費電力が大きい

機能化が困難

標準CMOSプロセス

一歩劣るが改善されつつある

消費電力が小さい

機能化が容易

よくある誤解

- x CCDというのは光検出素子の種類である CCD: Charge-Coupled Device
- × CMOSというのは光検出素子の種類である CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor

____ 実はどちらも,光検出の原理自体はほぼ同じである 信号の読み出し方が違うだけ

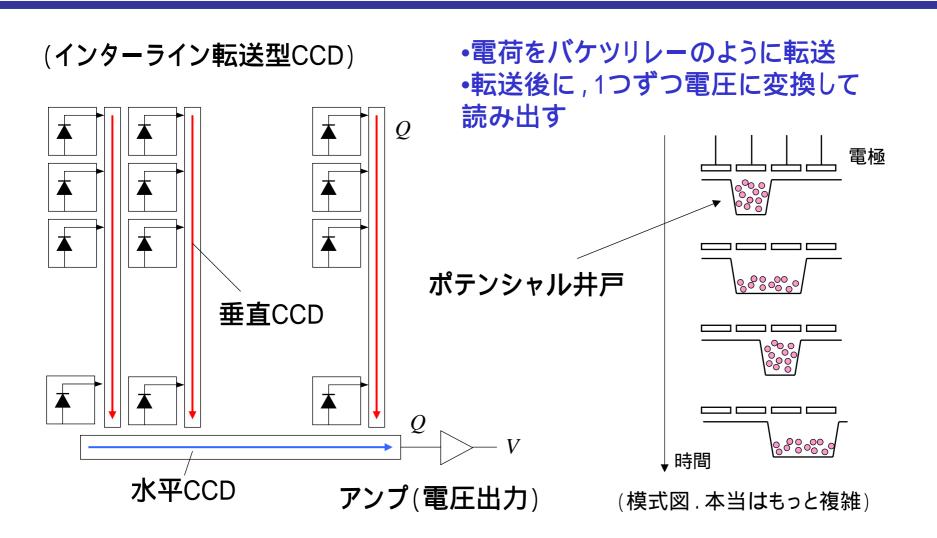
電気信号への変換

$$h
u$$
 $ightarrow$ Q $ightarrow$ V 光エネルギー 電荷 電圧

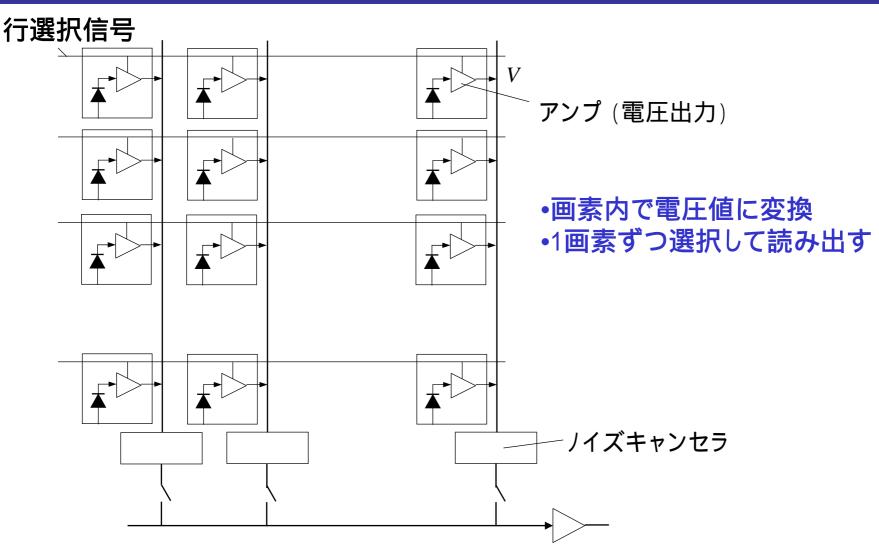
ここまでを画素で行うのがCCD (電圧への変換は画素アレイの外)

ここまでを画素で行うのがCMOS

CCD の場合



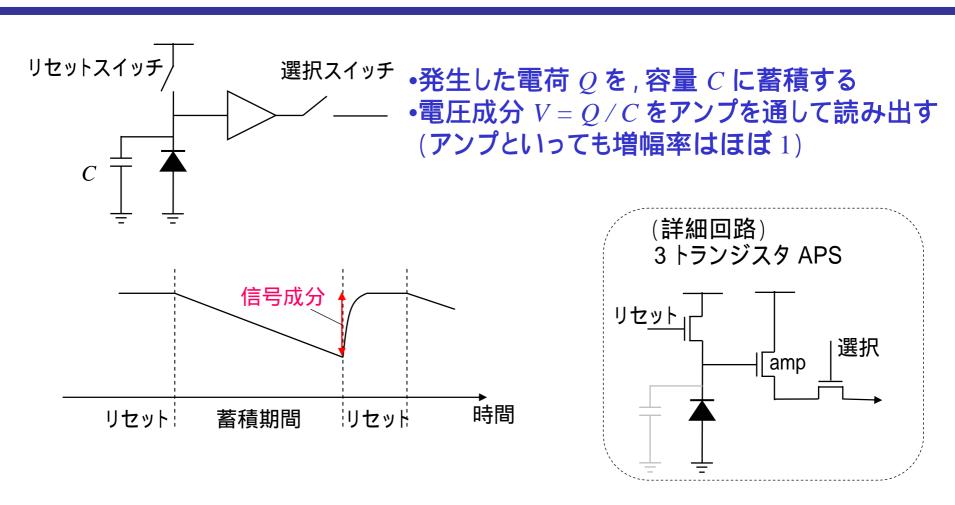
CMOS の場合



CMOS アクティブピクセルセンサ (APS)

鏡 慎吾 (東北大学): 知能制御システム学 2005.04.19

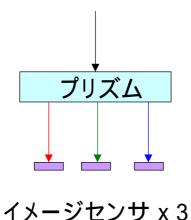
CMOS APS の画素構成



cf. アンプのない場合(パッシブピクセル)と比べて,低雑音,高速性,画素数に関するスケーラビリティなどで有利

カラー化

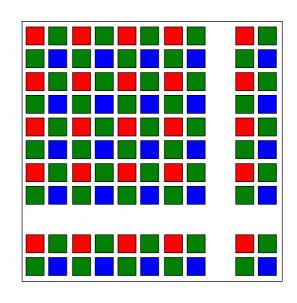
3板式



プリズムで光を RGB にわける 3つのイメージセンサで撮像

性能はよい.コストが高い

単板式



1つのイメージセンサ 画素ごとにカラーフィルタを並べる

性能は落ちる、コストは低い

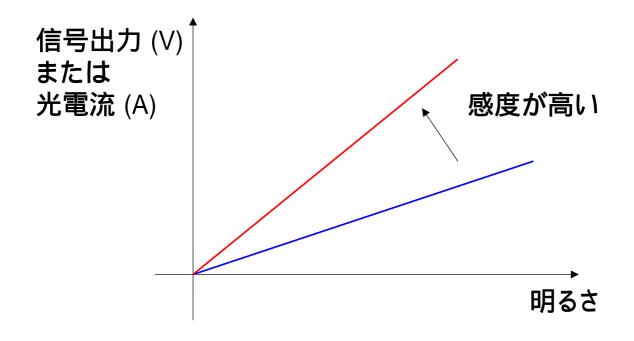
イメージセンサの性能

- •感度
- ・ノイズ
- •ダイナミックレンジ
- •空間解像度
- •速度

感度

入力である光の強さに対する信号の大きさの比

同じ強さの光に対して、大きな信号が出るほうが感度がよい



放射量と測光量

放射量 (物理的なエネルギーに基づ〈量)

測光量

(放射量の分光密度に標準 比視感度をかけて積分)

放射エネルギー [J]

エネルギーそのもの

光量 [lm·s]

放射束 [W]

単位時間あたり

光束 [lm]

放射照度 [W/m²]

単位時間·

単位面積あたり

照度 [lx]

放射強度 [W/sr]

e.g. 照明点光源

の明るさ

光度 [cd]

放射輝度 [W/sr/m²]

e.g. 照明面 の明るさ 輝度 [cd/m²]

イメージセンサの感度は, 例えば V/Ix/s など

感度を決める要因

量子効率 (quantum efficiency: QE)

フォトン1 に対して電子1 が 100% 厳密にはデバイスで決まる値だが,反 射・回折の影響を入れる場合も多い

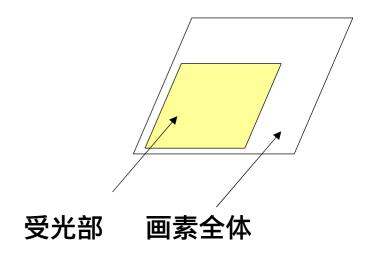
開口率 (fill factor)

受光部の面積 / 画素の面積

マイクロレンズの効率

電荷 電圧の変換効率

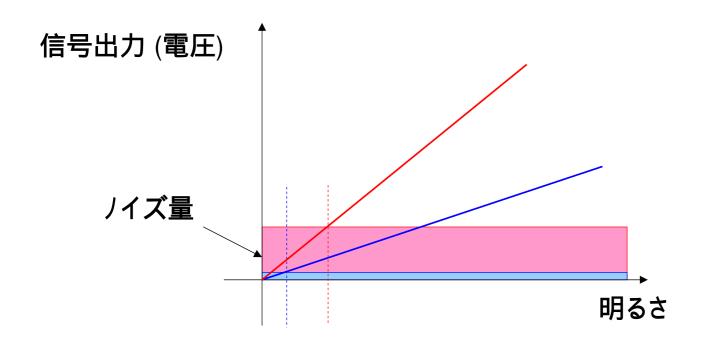
CCD なら画素の外, CMOSなら画素の中が勝負V = Q / C なので小さい容量で変換するのが重要



ノイズ

感度さえよければよいわけではない

ノイズによって,測定限界(感度限界)が決まる



赤で表されたセンサの方が「感度」はよいしかし、青で表されたセンサの方が暗いところまでよ〈撮れる

フォトダイオードのノイズ

暗電流:

光が当たっていないのに流れてしまう電流 流れる量が分かっているなら問題ない、実際には,画素ごとにば らついたり,ゆらいだりする

ショットノイズ:

不規則なゆらぎ成分.本質的に避けようがないとされる信号の電子数を N として N がノイズの平均電子数

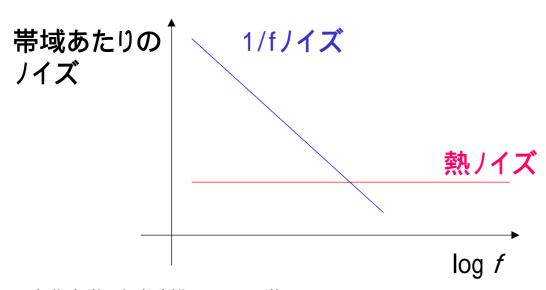
- •暗電流ショットノイズ
- •光ショットノイズ

単位時間当たり N 個の信号電荷が発生するとする,時間 t だけ蓄積すると, 蓄積される信号電荷は tN 蓄積される/イズ電荷は (tN) S/N 比は (tN).よって t に比例して S/N 比が改善する

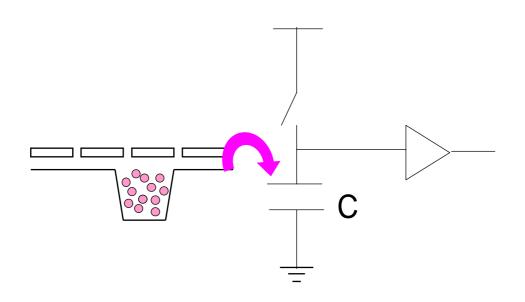
CCDイメージセンサのノイズ

電圧への変換アンプで発生するノイズ

- •リセットノイズ (kTCノイズ) サンプルホールド時に抵抗の熱雑音を拾ってしまう 相関二重サンプリング (CDS) によって除去可能 (後述)
- •アンプの 1/f ノイズ CDSによって抑圧効果あり
- •アンプの熱ノイズ



相関二重サンプリング



- 1. スイッチをオンにして C をリセット(充電)して,オフする(リセットノイズ発生)
- 2. 電圧を読み出す
- 3. 信号電荷を C に転送
- 4. 電圧を読み出す
- 5. 読み出した2回の電圧の差を取る (リセットノイズがキャンセルされる. 比較的近い時刻なので,1/fも抑圧される)

CCDイメージセンサのノイズ (その他特有のもの)

スミア

明るい部分の上下に縦に白いラインが発生 垂直CCDへの電荷混入が原因

残像

電荷を完全転送できずに次のフレームに残ってしまう 動画撮影時に問題

スミアの例

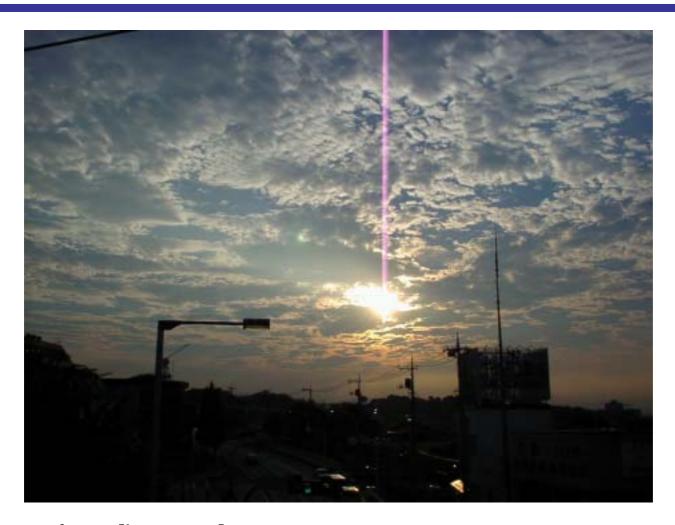


Photo. from [impress]

CMOSイメージセンサのノイズ

固定パターンノイズ 支配的

主にトランジスタ特性(しきい値)の製造時ばらつきによる

- ・画素にあるアンプのばらつき
- •列ごと回路のばらつき

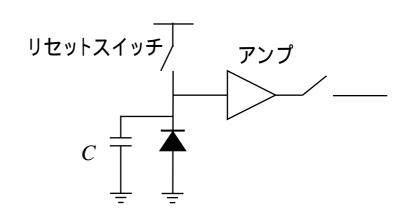
リセットノイズ

1/f //イズ

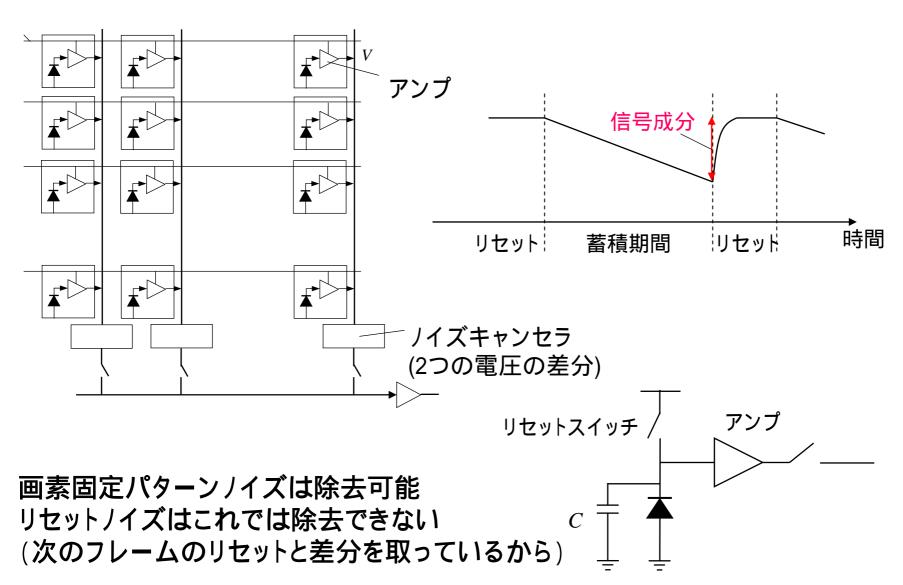
アンプの熱ノイズ

ショットノイズ

暗電流



CMOSイメージセンサのノイズ対策

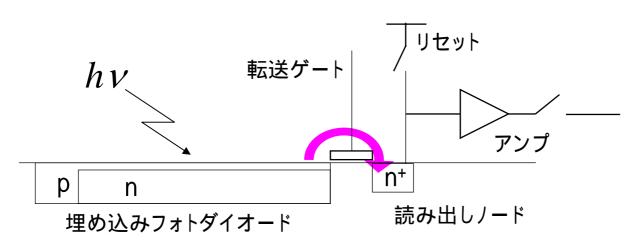


埋め込みフォトダイオード

- リセットノイズ除去可能
 - 1. 読み出しノードをリセットして,電圧を読み出す.
 - 2. 転送ゲートを開いて信号電荷を転送
 - 3. 電圧を読み出して,差分を取る
- ・ 暗電流が少ない
- 製造プロセスがやや特殊になる

(各社で呼び方が違う)

- Hole Accumulated Diode
- Pinned Photodiode



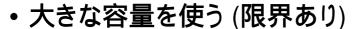
p基板

ダイナミックレンジ

定義: 検出できる最も明るい信号の, 最も暗い信号に対する比

DR [dB] =
$$20 \log \frac{i_{\text{upper_limit}}}{i_{\text{lower_limit}}}$$

- ・容量を充電し切ってしまう(飽和してしまう)ところで明るいほうの限界が生じる
- •暗いほうの限界はノイズで決まる



- 複数回サンプリングして合成
- 飽和検出 (時間,回数)
- 対数圧縮素子
- ・ポテンシャル井戸の開閉制御





シャープ(株)の広ダイナミックレンジイメージセンサの出力画像

Photo. from [nikkeibp]

• • •

空間解像度

最近は、売れるための最重要条件らしい

製造プロセスが進むとともに,画素サイズもどんどん小さくなっている

ダイナミックレンジに不安(蓄積容量が小さくなる)

CMOSの場合,回路量も減らす必要が出てきた.画素間で回路を共有する技術が去年あたり大ブームに

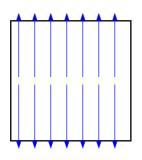
解像度が細かくなると,レンズ系の設計も難しくなる点に注意 (ひと昔前は 4μmが限界と言われていたが,あっさりその先に進んでいる)

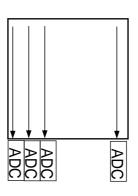
速度

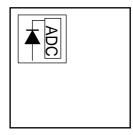
従来のビデオレート(30Hz/60Hz)を超える高速な画像出力の必要性が 認識され始めてきた

- ・並列同時読み出し
- 列並列 A-D 変換器 (ADC)
- 画素レベル ADC

数百×数百画素で 1000~10000 フレーム毎秒の物も出始めている







機能集積 CMOS イメージセンサ

カメラ・オン・チップ

周辺機能のオンチップ化

- •制御信号生成,電源生成
- •ADC
- •ゲイン制御
- ・色補正,ガンマ補正

画像処理機能の追加

- •列レベル/画素レベル
- •前処理
- •特徵抽出
- •画像圧縮·動画圧縮

一般に,画素レベルで何らかの処理を付加したイメージセンサを 「ビジョンチップ」「コンピュテーショナルセンサ」などと呼ぶ

References

[米本2003] 米本 和也: CCD/CMOSイメージ・センサの基礎と応用, CQ出版社,

2003.

[Wong1999] H-S. P. Wong and A. El Gamal, Single-Chip CMOS Imaging

Systems (Imagers), 1999 ISSCC Tutorial, 1999.

[impress] http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/990820/sanyo.htm

[nikkeibp] http://ne.nikkeibp.co.jp/device/2003/04/1000018072.html